## OPTICAL RECORDING MEDIUM

Publication number: JP2003260874

Publication date: 2003-09-16

Inventor: HARIGAI MASATO: FUJII TOSHISHIGE: KAGEYAMA

YOSHIYUKI; UMEHARA MASAAKI

Applicant: RICOH KK

Classification:

- International: B41M5/26; G11B7/24; B41M5/26; G11B7/24; (IPC1-7):

B41M5/26; G11B7/24

europear

Application number: JP20020063526 20020308
Priority number(s): JP20020063526 20020308

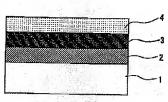
Report a data error here

#### Abstract of JP2003260874

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical recording medium which is highly evaluated in terms of recording sensitivity, image contrast before and after recording, regenerated signal (C/N ratio) and environmental resistance.

SOLUTION: The optical recording medium has

SOLUTION: The optical recording medium has two recording layers, i.e., a first recording layer (2) and a second recording layer (3). The first recording layer (2) is an alloy layer comprising In or Sb, and one element selected from among Ti, Pd, Zr and V, and the second recording layer is composed of Si or Ge. COPYRIGHT: (C)2003.PO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本阁特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-260874 (P2003-260874A)

(43)公開日 平成15年9月16日(2003.9.16)

(51) Int.Cl.7		機別記号	FI	-	5	j-73-ド(参考)
B41M	5/26		C11B	7/24	511	2H111
G11B	7/24	511			5 2 2 D	5D029
		5 2 2	B41M	5/26	х	

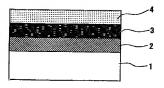
		審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 7 頁)
(21)出顧番号	特顧2002-63526(P2002-63526)	(71)出願人 000006747 株式会社リコー
(22) 出顧日	平成14年3月8日(2002.3.8)	東京都大田区中馬込1 厂目3番6号
		(72)発明者 針谷 眞人 東京都大田区中馬込1『目3番6号 株式 会社リコー内
		(72)発明者 藤井 俊茂 東京都大田区中馬込1 『目3番6号 株式 会社リコー内
		(74)代理人 100108121 弁理士 奥山 雄毅
		最終質に絞ぐ

#### 最終貝に鋭く

#### (54) 【発明の名称】 光記録媒体

## (57)【要約】

【課題】 高密度対応の追記型光記録媒体において、記録感度、記録前後のコントラスト、再生信号(C/N



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも基板と記録層とを備え、基板 側から光を記録層に照射することにより情報を記録又は 再生する追記型の光記録媒体において、

### 記録層は三層から成り、

二層の記録層の内、基板側に設けられる第一記録層が、 In又はSbと、 Ti、Pd、Zr、Vの中から選ばれた一つの元素とから成る合金層であり、

第一記録層上に設けられる第二記録層が、Si又はGeから成る層である事を特徴とする光記録媒体。

# 【請求項2】 前記光記録媒体において、

第一記録層を構成する合金層の組成式をA<sub>100-x</sub>B <sub>x</sub>と表し、In又はSbをAとし、Ti、Pd、Zr、 Vの中から選ばれた一つの元素をBとするとき、 BがTiの場合は、

0<x≤10(但しxは原子%) の範囲内である事を 特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。

#### 行成とする前求項1に記載の元記録媒体。 【請求項3】 前記光記録媒体において、

第一記録層を構成する合金層の組成式をA<sub>100-x</sub>B xと表し、In又はSbをAとし、Ti、Pd、Zr、 Vの中から選ばれた一つの元素をBとするとき、 BがPdの場合は

1≤×≤25 (但し×は原子%) の範囲内である事を 特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。

# 【請求項4】 前記光記録媒体において、

第一記録層を構成する合金層の組成式をA<sub>100-×</sub>B<sub>x</sub>と表し、InXはSbをAとし、Ti、Pd、Zr、Vの中から選ばれた一つの元素をBとするとき、 BがZrの場合は

0<x≤5(但しxは原子%) の範囲内である事を特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。

## 【請求項5】 前記光記録媒体において、

第一記録程を構成する合金層の組成式をA<sub>100-x</sub>B <sub>x</sub>と表し、In又はSbをAとし、Ti、Pd、Zr、 Vの中から選ばれた一つの元素をBとするとき、 BがVの場合は

0<x≤2(但しxは原子%) の範囲内である事を特徴とする請求項1に記載の光記録媒体。</p>

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、追記型の光記録媒 体に関する。

### [0002]

【従来の技術】電磁波、特にレーザ照射によりデータの 記録又は再生を行う追踪型の光記録媒体としては、レー 呼照射により数体にピット(月)をあけるピット方式 や、相変化又は合金化等による構造変化を生じさせて反 財率を変化させて情報を記録する相変化方式又は合金化 方式が提案されている。例えばピット方式の場合、情報 を記録する記録図として「で限を用いる研究分組み、そ の中で報環境特性を改善するため、特開昭58-189 850号公留では丁ε限表面に酸化膜を形成する技術が 開示されている。同じく、耐環境特性の改善のため、記 録層として下eにSeやCを添加した提案やCS<sub>2</sub>-T e膜の検討も進められた。また、Te膜の記録感度の向 上のために、特開昭58-9234号公報ではBi、Z n、Cd、In、Sb、Snとの合金化により低融点化 を図る技術が開示されている。

 $\{00031$ 一方、相変化方式としては、代表的なものとして、 ${\rm Teo}_{\lambda}$  放びたれに ${\rm Ge}_{\lambda}$  Sn、 ${\rm Pb}$  を添加した案や、 ${\rm Bi}_{2}$  Teo $_{3}$  を反射層、 ${\rm Sh}_{2}$  Se $_{3}$  を相変化記録層とした二層タイプのものが提案されている。また、合金化方式としては、 ${\rm Ge}_{\lambda}$  Sn、 ${\rm Sn}_{\lambda}$  元元素の静から選択された少なくとも一種の元素から成る層と、 ${\rm Au}$  、 ${\rm Ag}_{\lambda}$  Al、 ${\rm Cu}$  の元素部から選択された少なくとも一種の元素から成る層に、レーザ光を照射して、この一層を合金化させて記録する技術が特開平4-226784号公器に提案されている。

#### [0004]

【発明が解決しようとする問題】しかしながら、ビット方式の場合、記録帝度の向上に伴い、歩一なヒットを得ることが阻棄となり、これにより前環境特性と記録恋度が低下してしまう。また、相変化方式の場合、結晶と非結晶の間の相転移を利用するもので、高温高速条件下等の保存環境により記録が消去されてしまう危険性がある。合金位方式の場合、レーザ照射による反射率の変動即も記録した再生信号のコントラストが小さく、再生時に読み取りエラーが発生しやすいという問題を有する後で、大本発明の目的は、上記役来技術に鑑みなされたものであり、高密度対応の追記型光記録媒体において、再生信号のコントラストが良好で、記録恋皮が充分に高くかつ相様は特性に扱れた光記録媒体を提供することを目的とするものである。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、請求項1に記載の本発明は、少なくとも基板と記録 層とを備え、基板側から光を記録層に照射することによ り情報を記録又は再生する追記型の光記録媒体におい て、記録層は二層から成り、二層の記録層の内、基板側 に設けられる第一記録層が、In又はSbと、Ti、P d. Zr. Vの中から選ばれた一つの元素とから成る合 金層であり、第一記録層上に設けられる第二記録層が、 Si又はGeから成る層である事を特徴とする光記録媒 体とする。 請求項2に記載の本発明は、前記光記録媒体 において、第一記録層を構成する合金層の組成式をA 100-VBvと表し、In又はSbをAとし、Ti、 Pd、Zr、Vの中から選ばれた一つの元素をBとする とき、BがTiの場合は、0<x≤10(但しxは原子 %) の範囲内である事を特徴とする、請求項1に記載 の光記録媒体とする。請求項3に記載の本発明は、前記

光記録媒体において、第一記録層を構成する合金層の組 成式をA<sub>100-x</sub>B<sub>x</sub>と表し、In又はSbをAと し、Ti、Pd、Zr、Vの中から選ばれた一つの元素 をBとするとき、BがPdの場合は、1≤x≤25 (但 しxは原子%) の範囲内である事を特徴とする、請求 項1に記載の光記録媒体とする。請求項4に記載の本発 明は、前記光記録媒体において、第一記録層を構成する 合金層の組成式をA<sub>100-x</sub>B<sub>x</sub>と表し、In又はS bをAとし、Ti、Pd、Zr、Vの中から選ばれた一 つの元素をBとするとき、BがZrの場合は、O<x≤ 5(但しxは原子%) の範囲内である事を特徴とす る、請求項1に記載の光記録媒体とする。請求項5に記 載の本発明は、前記光記録媒体において、第一記録層を 構成する合金層の組成式をA<sub>100-x</sub>B<sub>x</sub>と表し、I n又はSbをAとし、Ti、Pd、Zr、Vの中から選 ばれた一つの元素をBとするとき、BがVの場合は、O < x ≤ 2 (但しx は原子%) の範囲内である事を特徴 とする、請求項1に記載の光記録媒体とする。 [0006]

(1) 側から照射され、二層の記録層の相互拡散による 光学的変化を利用して記録層の反射率を変化させ、情報 を記録する。

【0007】第一記録層(2)は、In又はSbと、T i、Pd、Zr、Vの中から選ばれる一つの元素とから 成る合金層であり、第二記録層(3)はSi又はGeか ら成る層である。第一記録層(2)は、電磁波、例えば レーザ光の入射側である基板(1)上に設けられ、第二 記録層(3)はその上に設けられる。このような構成に より、記録層はレーザ光照射側の記録モードが高く、本 発明の光記録媒体は未記録時の反射率が45%以上の高 い反射率と、記録前後でのコントラストが0.6以上. 再生信号 (C/N比) が60dB以上という良好な記録 特性を実現することができる。 記録のために基板 (1) 側からレーザ光、例えば波長650 nmの半導体レーザ が入射すると、第一記録層(2)と第二記録層(3)と で入射した光を吸収、発熱し、この二つの記録層を構成 する各元素の相互拡散と記録層の変形により、記録前後 で大きなコントラストが得られる。

【0008】第一記録層(2)に用いるIn及びSbは、単体の場合は多結論の為に設界によるノイズが発生するが、Ti、Pd、Zr、Vの中から選ばれる一つの元素との合金層とすることにより、層が観音を構造となり、ノイスを低減し、C/N比を向上させる。これは、Ti、Pd、Zr、Vの元素が、母材であるIn及びSbの約成長を抑止するものと思われる。また、これらの元素はIn及びSbの終化発達を防止する機能を有する、所収等材性を向上させる。第二段経過(3)に用いるSi及びGeは、禁止帯の場が小さく、第一記録層(1)を遊過た光を吸収することができ、光の吸収効率を向上させて許多級収力をことができ、光の吸収効率を向上させて許熱級度を上げる。

【0010】また木発明では、BがPdの場合は、 1≤x≤25

の範囲内であることを特徴とする。この範囲内とすることで新環境特権及びC/N比が向上し、ノイズのない光 記録媒体を得ることができる。xが1原子※未満である と環境特性が低下する。25原子%より大きいと反射 準が低下し、記録感度及びC/N比が低下する。

【0011】また本発明では、BがZrの場合は、 0<x≤5

の範囲内であることを特徴とする。BがZrの場合は前途のTiの場合と関鍵に、僅かな量、例えば0.1原子 次でも前環境特性の向上に効果がある。5原子%より大きくなると影秘を感好が低下する。

【0012】また本発明では、BがVの場合は、0<x ≤2の範囲であることを特徴よする。BがVの場合は前 途のTiや2rの場合と同様に、億かな量、例えば0. 1原子%でも耐環境特性の向上に効果がある。2原子% 以上になると記録感度が低下する。

【0013】上達のように、本売明の光記録媒体の記憶原理は、第一記録層(2)と第二記録層(3)との間の相互拡散による光学的変化を利用するものであるが、二層の記録層の内、電磁波を照射される悲板(1)側に記録モードの高い第一記録層(2)を設けることで記録時に溶融しやすく、第二記録層(3)を第一記録層(2)上に設けることで高い探弁学性を得ることができる。この二層の記録層の構成を逆にすると、照射光が第二記録層(3)で吸収されてしまい、反射率が悪くなる。また、本発明の光記録媒体には、固体時の体積変化に伴う基板(1)の変形等の効果が重合されており、高レベル

な再生信号を得ることができ、読み取りエラーのない。 極めて大きいコントラストを実現することができる。 【0014】各記録層の成膜法としては、各種気相成長 法、例えば真空蒸着法、スパッタリング法、電子ビーム 法等があるが、とくにスパッタリング法が好ましい。第 一記録層(2)の膜厚は5nmから30nm、好ましく は10 nmから20 nmの範囲が良い。5 nmより薄い と反射率が45%以下に低下し、30nmより厚いと記 録感度が悪くなる。また、第二記録層(3)の隙厚は1 Onmから40nm、好ましくは20nmから30nm の範囲が良い。10nmより薄いとコントラストが低下 し、40nmより厚いと記録感度が悪くなる。基板 (1)の材料は、通常、ガラス、セラミック、或いは樹 脂が用いられ、樹脂基板が成形性の点で好ましい。代表 例としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、エ ボキシ樹脂、ポリスチレン樹脂、ボリエチレン樹脂、ボ リプロピレン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、A BS樹脂、ウレタン樹脂等が挙げられるが、加工性、光 学特性等の点からポリカーボネート樹脂が好ましい。ま

た、基板(1)の形状は、ディスク状、カード状、ある いはシート状であってもよい。環境保護層(4)の材料 は、紫外線硬化性の樹脂を用いることができる。化学的 安定性、機能的強度等を考慮するとエポキシ系樹脂が好 ましく、第二記録層(3)上にスピンコート法により設 けることが好ましい。

## [0015]

【実施例】以下、実施例により本発明を詳細に説明する。図1の構成のディスク状光記録媒体と作製した。基板(1)は、ピッチ0.74μm、案内清深さ40μm、原さ0.6mm、直径120mmのポリカーボネート基板であり、基板(1)上に第一記録層(1)と第二記録層(3)から成る記録層を順次スパック法により能成を示す。表1に示すように、実施例1から12は本発明による構成であり、比較例1から3は第一記録層をIn 又払り構成であり、比較例1から3は第一記録層をIn 又払り機成であり、比較例1から3は第一記録層をIn 又払り機成であり、比較例1から3は第一記録層をIn 又払り機成であり、比較例1から3は第一記録層をIn 又表も構成であり、比較例1から3位第一記録層をIn 又表も機成であり、比較例1から3位第一記録層をIn 又表も機成であり、比較例1から3位第一記録層をIn 又表も機成であり、比較例1から3位第一記録層をIn 又表も機成であり、比較例1から3位第一記録層をIn 又表も

	に対	骨材料	展度(pm)		
	第一記錄權	第二紀常層	第一記録層	第二紀錄門	
実施例で	In <sub>es</sub> Ti <sub>s</sub>	Ge	10	20	
実施例2	In <sub>so</sub> Pd <sub>10</sub>	Ge	10	20	
実施例3	In <sub>ey</sub> Zr <sub>3</sub>	Ge	10	20	
突施例4	In <sub>98</sub> V <sub>2</sub>	Ge	10	20	
実施例5	Lites Tig	Si	10	20	
実施例6	In <sub>98</sub> Pd <sub>6</sub>	SI	10	20	
実施例7	IngaZr <sub>2</sub>	Si	10	20	
宾施例8	In <sub>e8</sub> V <sub>2</sub>	Si	10	20	
奥施例9	Sb <sub>95</sub> Ti <sub>5</sub>	Ge	10	20	
実施例10	Sb <sub>20</sub> Pd <sub>10</sub>	Ge	10	50	
実施例11	Sb <sub>27</sub> Zr <sub>3</sub>	Si	10	20	
実施例12	Sb <sub>as</sub> V <sub>2</sub>	81	10	20	
比較例1	In	Ge	10	20	
比較例2	Sb	Ge	10	20	
比較例3	In	Si	10	20	
比較例4	Te <sub>95</sub> Se <sub>5</sub>	_	20		
比較例5	Ge	Al	20	10	

【0016】また、得られた光記録媒体の信号特性は、 再生信号(C/N比)と記録前の反射率、記録前後のコ ントラストで評価した。記録信号はEFMラングムパタ ーンを用い、記録パワーは8mW、10mW、12mW とした、記録練選は6m/sで行い、C/N比は3T信 号で評価した。記録再生用光源の半導体レーザの波長は

- 650nmのものを用いた。また、耐環境特性は80 で、85%温速下で、200時間保存後の記録マーク (10mW記録)のC/N比と反射率で評価した。以上 の結果を表2に示す。
- 【表2】

	三峰パワ ~	C/NHL THE		反射率(%)	分理点特性	
	(mm)	(dB)	·		C/N比(dB)	反射率(%)
	8	61	0. 85	47		
実質例1	10	61	0. 66	47	60	48
	12	61	0.66	_ 47 _		
	8	61	0. 86	48	1	
実施例2	10	61	0. 68	48	60	45
	12	81	0. 65	48		
実施例3	8	60	0. 65	47		
2000	10 12	60	0. 65	47	59	46
	R R	61	0.65	47		
実施例4	10	61	0. 67	47		
PAR 1714	1 12	61	0. 67	47 47	60	46
	16	80	0. 67	46		
実施例5	1 %	61	0. 68 0. 68	46	80	45
~~	12	61	0.68	46	-60	40
	100	69	0.66	48		
実施側6	10	60	0.67	48	59	46
2000	12	61	0. 67	48	00	46
	8	60	0. 67	46		
実施例7	10	61	0.67	46	60	45
	12	61	0.67	46		,,,
	В	61	0.68	46		
突進例8	10	62	0.68	46	61	45
	12	62_	0.68	46		
***	8	60	0. 67	47		
突旋例9	10	61	0. 68	47	60	45
	12	52	0.68	47		
***	В	62	0. 67	46		
実施例10	10	62	0.67	46	61	45
	12	<u>52</u>	0, 67	46		
安監督11	8	62	0.65	47		
7.00 P. 1 1	12	62	0.65	47	61	43
	12	62	0.65	47		
寒遊倒12	10	61	0. 66 0. 66	48	[	
	12	62	0.86	4B 4B	60	43
	8	62 68	0.66	48		
比較例1	10	58	0.85	46	62	39
	12	59	0.65	46	- P	- 09
	8	- BB	0.66	46		
比較例2	10	59	0.86	46	51	38
	iž	59	0.66	45		
	8	57	0.84	45		
比較例3	10	58	0.85	45	50	35
	12	58	0.65	45		
	8	53	0.64	41		
比较例4	10	54	0. 64	41	46	35
	12	54	0.64	41	1	
	8	54	0.63	20		
比較例5	10	54	0.63	20	51	1/
1	12	54	0, 63	20		

【0017] 表1及び表2からわかる様に、実施例1から12ではいずれの記録パワーにおいてもC/N比が59dB以上であり、いずれも比較例1から5より高い記録感度を有すると同時にコントラストも0.6以上であった。また、未記録の反射率も全て45%以上あり、ディスク状治証録媒体(DVD-R)の初順反射率の規格は特に耐取媒体性において優九、高温高温を作で200時間保存後も良好な特性を示した。一方、比較例1から5では、C/N比、コントラスト、反射率、耐環境特性のなどの値を満足するものは得られず、本発明より明らかに特性が劣ることがかかった。

[0018]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に よれば、記録時の記録態度が高く、低い記録・パワーであ っても対応でき、再生信号と・ノイズが発生せず、かつ耐 環境特性に優れ、記録した情報を確実に保存することが 可能な追屈型の光記録媒体を提供することができる。 【別所の簡単を選明】

【図1】本発明の光記録媒体の構成を示す概略図であ

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 第一記録層
- 3 第二記録層
- 4 環境保護層

【図11



#### 【手続補正書】

【提出日】平成14年6月28日(2002, 6, 2 8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004 【補正方法】変更

【補正内容】

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、 ピット 方式の場合、記録密度の向上に伴い、均一なピットを得 ることが困難となり、これにより再生信号特性と記録感 度が低下してしまう。また、相変化方式の場合、結晶と 非結晶の間の相転移を利用するもので、高温高温条件下 等の保存環境により記録が消去されてしまう危険性があ る。合金化方式の場合、レーザ照射による反射率の変動 即ち記録した再生信号のコントラストが小さく、再生時 に読み取りエラーが発生しやすいという問題を有する。 従って本発明の目的は、上記従来技術に鑑みてなされた ものであり、高密度対応の追記型光記録媒体において、 再生信号のコントラストが良好で、記録感度が充分に高 く、かつ耐環境特性に優れた光記録媒体を提供すること を目的とするものである。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】第一記録層(2)は、In又はSbと、T i、Pd、Zr、Vの中から選ばれる一つの元素とから 成る合金層であり、第二記録層(3)はSi又はGeか ら成る層である。第一記録層(2)は、電磁波、例えば レーザ光の入射側である基板(1) トに設けられ、第一 記録層(3)はその上に設けられる。このような構成に より、本発明の光記録媒体は未記録時の反射率が45% 以上の高い反射率と、記録前後でのコントラストが〇. 6以上、再生信号 (C/N比) が60d B以上という良 好な記録特性を実現することができる。記録のために基 板(1)側からレーザ光、例えば波長650 nmの半達 体レーザが入射すると、第一記録層(2)と第一記録層 (3)とで入射した光を吸収、発熱し、この一つの記録 層を構成する各元素の相互拡散と記録層の変形により、 記録前後で大きなコントラストが得られる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】上述のように、本発明の光記録媒体の記録 原理は、第一記録層(2)と第二記録層(3)との間の 相互拡散による光学的変化を利用するものであるが. -層の記録層の内、電磁波を照射される基板(1)側に融 点の低い第一記録層 (2)を設けることで記録時に溶融 しやすく、第二記録層(3)を第一記録層(2) Hに設 けることで高い記録感度を得ることができる。この二層 の記録層の構成を逆にすると 昭射光が第二記録層 (3)で吸収されてしまい、反射率が悪くなる。また、

本発明の光記録媒体には、固体時の体積変化に伴う基板 (1)の変形等の効果が重合されており、高レベルな再 生信号を得ることができ、読み取りエラーのない 極め て大きいコントラストを実現することができる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】 [0015]

【実施例】以下、実施例により本発明を詳細に説明す る。図1の構成のディスク状光記録媒体を作製した。基 板(1)は、ピッチ0.74μm、案内溝深さ0.04 μm、厚さ0.6mm、直径120mmのポリカーボネ ート基板であり、基板(1)上に第一記録層(1)と第 二記録層(3)から成る記録層を順次スパッタ法により 設けた。表1に本実施例及び比較例における記録層の構 成を示す。表1に示すように、実施例1から12は本発 明による構成であり、比較例 1 から 3 は第一記録層を I n又は S b 単体で用いて合金化しなかったものである。 【表1】

	26/	材料	排型(nm)		
	第一記學者	第二紀紀暦	第一記錄用	第二記録層	
実施例1	In <sub>es</sub> Ti <sub>5</sub>	Ge	10	50	
实施例2	In <sub>90</sub> : <sup>3</sup> d <sub>10</sub>	Ge	10	20	
实施例3	In <sub>e7</sub> Zr <sub>3</sub>	Ge	10	20	
宴進例4	IngsV <sub>2</sub>	Ge	10	30	
実施例5	In <sub>92</sub> Ti <sub>8</sub>	Si	10	80	
実施例6	In <sub>26</sub> Pd <sub>5</sub>	Si	10	80	
実施例7	InggZr <sub>2</sub>	Si	10	20	
実施例8	in <sub>ss</sub> V <sub>2</sub>	Si	10	20	
奥崑例9	Sb <sub>95</sub> Ti <sub>8</sub>	Ge	10	20	
実施例10	Sb <sub>90</sub> Pd <sub>10</sub>	G.	. 10	20	
実施例11	Sb <sub>97</sub> Zr <sub>8</sub>	Si	10	20	
実施約12	Sb <sub>98</sub> V₂	Si	10	20	
比較例1	In	Ge	10	20	
比較例2	Sb	Ge	10	20	
比較例3	In	Si	10	20	
比較例4	Te <sub>96</sub> Se <sub>6</sub>	_	20		
比較例5	Ge	Al	20	10	

### フロントページの続き

(72)発明者 影山 喜之 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内 (72)発明者 梅原 正彬 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

F ターム(参考) 2H111 EA03 EA21 FA02 FB04 FB05 FB09 FB16 FB21 FB30 5D029 JA01 JB03 JB21